

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 4 区分

【発行日】平成 24 年 5 月 24 日 (2012.5.24)

【公開番号】特開 2011-60402 (P2011-60402A)

【公開日】平成 23 年 3 月 24 日 (2011.3.24)

【年通号数】公開・登録公報 2011-012

【出願番号】特願 2009-211544 (P2009-211544)

【国際特許分類】

G 1 1 C 11/412 (2006.01)

G 1 1 C 11/41 (2006.01)

G 1 1 C 11/413 (2006.01)

【F I】

G 1 1 C 11/40 3 0 1

G 1 1 C 11/34 3 4 5

G 1 1 C 11/34 M

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 3 月 28 日 (2012.3.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

データの読み出し又は書き込みが行われる第 1 のメモリセルが行列状に複数配置された第 1 のメモリセルアレイと、

対応する列に配置された複数の前記第 1 のメモリセルのうち、何れかの第 1 のメモリセルのデータを増幅し記憶する第 2 のメモリセルが、行列状に複数配置された第 2 のメモリセルアレイと、を備え、

前記第 1 及び前記第 2 のメモリセルアレイは、互いに列方向に対向配置され、

前記第 2 のメモリセルは、前記第 1 のメモリセルよりも面積が大きく、

前記第 1 のメモリセルアレイは、前記第 2 のメモリセルアレイの 2 倍以上の面積である半導体記憶装置。